СВЕДЕНИЯ

об официальном оппоненте

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, Имя, Отчество (полностью) | Место основной работы - полное наименование организации (с указанием полного почтового адреса, телефона (при наличии), адреса электронной почты (при наличии)), должность, занимаемая им в этой организации (полностью с указанием структурного подразделения) | Ученая степень (с указанием отрасли наук, шифра и наименования научной специальности, по которой им защищена диссертация в соответствии с действующей Номенклатурой специальностей научных работников) | Ученое звание  |
| Орлов Лев Константинович  | Институт физики микроструктур РАН – филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук»  Фактический адрес: 603087, Нижегородская область, Кстовский район, д.Афонино, ул. Академическая, д.7  Почтовый адрес: 603950, г.Нижний Новгород, ГСП-105  Ведущий научный сотрудник отдела физики полупроводниковE-mail: orlov@ipm.sci-nnov.ru  | Доктор физико-математических наук По специальности 01.04.07 - физика твердого тела    | Старший научный сотрудник  |
|   |   |   |   |
| [[1]](#footnote-1)Основные публикации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций):  |
|  1. Орлов Л.К., Вдовин В.И., Дроздов Ю.Н., Ивина Н.Л., Орлов М.Л., Штейнман Э.А. Характеризация интерфейсных слоев твердого раствора, формируемых при росте на кремнии из водородсодержащих соединений карбидного слоя. // Журнал структурной химии, 2021, Т.62. №4. С. {L.K. Orlov, V.I. Vdovin, Yu.N. Drozdov, N.L. Ivina, M.L. Orlov, E.A. Steinman. Characterization of interface layers of a solid solution formed during the growth of a carbide layer on silicon from hydrogen containing compounds.// Journal of Structural Chemistry, 2021, Vol.62, No 4, P. 672-683}
2. Орлов М.Л., Орлов Л.К. Особенности транспорта электронов в двумерных квантовых сверхрешетках с неассоциативным законом дисперсии. // Физика и техника полупроводников, 2021, Т.55. № 3. С.241-249 {M.L. Orlov, L.K. Orlov. Features of electron transport in two-dimensional quantum superlattices with the non-associative dispersion law.// Semiconductors, 2021, vol.55. No 3. p. 319-327}
3. Orlov L.K., Vdovin V.I., Ivina N.L., Steinman E.A., Drozdov Yu.N., Orlov M.L. Low temperature growth of the nanotextured island and solid 3C-SiC layers on Si from hydric Si, Ge and C compounds. // Crystals 2020, v.10, p.491 (1-14) MDPI, Switzerland
4. Орлов Л.К., Вдовин В.И., Ивина Н.Л. Микрокристаллическая структура и светоизлучающие свойства 3С-SiC островковых пленок, выращиваемых на поверхности Si(100). // Физика твердого тела, 2019, т. 61, вып.7, с.1322-1330. {Orlov L.K., Vdovin V.I., Ivina N.L. Microcrystalline Structure and Light-Emitting Properties of 3C–SiC Island Films Grown on the Si(100) Surface. // Physics of the Solid State, 2019,

Vol.61, N.7, p.1263-1271}  1. Орлов Л.K., Ивина Н.Л., Боженкин В.А. Особенности начальной стадии гетероэпитаксии слоев кремния на германии при их выращивании из гидридов кремния. // Физика и техника полупроводников, 2019, т.53, вып. 7, с. 995-1005 {Orlov L.K., Ivina N.L., Bozhenkin V.A. Futures of the initial stage of the heteroepitaxy of Silicon layers on Germanium when grown from Silicon hydrides. Semiconductors, 2019, Vol.53, No.7, p. 979-988.}
2. Орлов М.Л., Волкова Н.С., Ивина Н.Л., Орлов Л.К. Электрополевое поведение резонансных особенностей в туннельной составляющей фототока в гетероструктурах

InAs(QD)/GaAs. // Физика и техника полупроводников, 2018, 52 (9), 1006-1014. {Orlov M.L., Volkova N.S., Ivina N.L., Orlov L.K. Electric-field behavior of the resonance features of the tunneling photocurrent component in InAs(QD) / GaAs heterostructures. // Semiconductors, 1918, 52, N.9, 1129-1136} 1. Орлов Л.K., Ивин С.В., Фомин В.М. Влияние атомарных пучков кремния и германия на кинетику роста слоев Si1-хGeх в методе Si-GeH4MBE. // ЖТФ, 2017, т.87, №3 , с.427437 {Orlov L.K., Ivin S.V., Fomin V.M. Effect of atomic silicon and germanium beams on the growth kinetics of SiGe layers in Si-GeH4 molecular beam epitaxy. // Technical physics, 2017, Vol. 62, No. 3, pp. 449–459.}
2. Орлов Л.K., Ивин С.В. Кинетика распада дисилана на поверхности кремния на два неидентичных радикала. // Химическая физика, 2016, т.35, № 3, c. 36-48 {Orlov L.K., Ivin S.V. Kinetics of the Decomposition of Disilane on a Silicon Growth Surface into Two Non-Identical Radicals. // Russian Journal of Physical Chemistry B, 2016, Vol. 10, No. 2, pp. 219–230}

   |

1. Список публикаций приводится с полным библиографическим описанием согласно ГОСТ 7.1-2003. [↑](#footnote-ref-1)